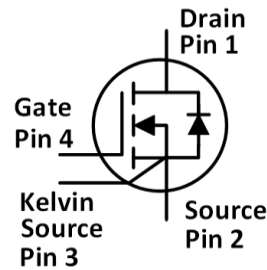
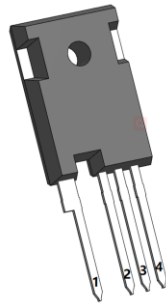


IV2Q12017T4Z – 1200V 17mΩ 第二代车规级 SiC MOSFET

特点

- 第二代 SiC MOSFET 技术
- 推荐使用 18V 栅压驱动
- 高压、低导通电阻
- 高速、寄生电容小
- 高工作结温
- 快速恢复体二极管
- 开尔文连接驱动

封装示意图:

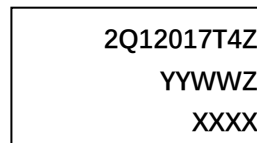


应用

- EV 主驱逆变器
- 光伏逆变器
- 电机驱动
- 高压 DC/DC 变换器
- 开关电源

TO247-4

丝印示意图:



2Q12017T4Z = Specific Device Code
YY = Year
WW = Work Week
Z = Assembly Location
XXXX = Lot Traceability

最大额定值 (T_c=25°C, 特殊说明除外)

符号	参数说明	典型值	单位	测试条件	备注
V _{DS}	漏源电压	1200	V	V _{GS} =0V, I _D =100μA	
V _{GSmax} (DC)	最大直流栅源电压	-5 to 20	V	静态 (DC)	
V _{GSmax} (Spike)	最大尖峰栅源电压	-10 to 23	V	占空比<1%, 脉冲宽度<200ns	
V _{GSon}	推荐使用的开通栅源电压	18±0.5	V		
V _{GSoff}	推荐使用的关断栅源电压	-3.5 to -2	V		
I _D	最大漏源电流	118	A	V _{GS} =18V, T _C =25°C	图 23
		87	A	V _{GS} =18V, T _C =100°C	
I _{DM}	最大脉冲漏源电流	295	A	根据器件安全工作区确定	图 26
P _{TOT}	最大耗散功率	469	W	T _C =25°C	图 24
T _{stg}	存储温度范围	-55 to 175	°C		
T _J	工作结温范围	-55 to 175	°C		
T _L	焊接温度	260	°C	引线处波峰焊接, 距外壳 1.6 毫米, 持续不超过 10 秒	

热阻特性

符号	参数说明	典型值	单位	备注
R _{θ(j-c)}	结到外壳的热阻	0.271	°C/W	图 25

电学特性 (T_c=25°C, 特殊说明除外)

符号	参数说明	规范值			单位	测试条件	备注
		最小	典型	最大			
I _{DSS}	关断时的漏极漏电流		5	100	μA	V _{DS} =1200V, V _{GS} =0V	
I _{GSS}	栅极漏电流			±100	nA	V _{DS} =0V, V _{GS} =-5~20V	
V _{TH}	阈值电压	1.8	2.8	4.5	V	V _{GS} =V _{DS} , I _D =20mA	图 8, 9
			2.1			V _{GS} =V _{DS} , I _D =20mA @ T _J =175°C	
R _{ON}	导通电阻		17	22	mΩ	V _{GS} =18V, I _D =60A @T _J =25°C	图 4, 5, 6, 7
			34		mΩ	V _{GS} =18V, I _D =60A @T _J =175°C	
C _{iss}	输入电容		4410		pF	V _{DS} =800V, V _{GS} =0V, f=100kHz, V _{AC} =25mV	图 16
C _{oss}	输出电容		211		pF		
C _{rss}	反向传输电容		16.3		pF		
E _{oss}	输出电容存储能量		81		μJ		图 17
Q _g	栅极总电荷		214		nC	V _{DS} =800V, I _D =60A, V _{GS} =-3 to 18V	图 18
Q _{gs}	栅源电荷		55		nC		
Q _{gd}	栅漏电荷		69		nC		
R _g	栅极输入电阻		1.9		Ω	f=1MHz	
E _{ON}	开通能量		1280		μJ	V _{DS} =800V, I _D =60A, V _{GS} =-3.5 to 18V, R _{G(ext)} =2.0Ω, L=200μH T _J =25°C	图 19, 20
E _{OFF}	关断能量		333.5		μJ		
t _{d(on)}	导通延迟时间		17.1		ns		
t _r	上升时间		33.2				
t _{d(off)}	关断延迟时间		35.5				
t _f	下降时间		15.1				
E _{ON}	开通能量		1544		μJ	V _{DS} =800V, I _D =60A, V _{GS} =-3.5 to 18V, R _{G(ext)} =2.0Ω, L=200μH T _J =175°C	图 22
E _{OFF}	关断能量		357.4		μJ		

体二极管特性 (T_c=25°C, 特殊说明除外)

符号	参数说明	规范值			单位	测试条件	备注
		最小	典型	最大			
V _{SD}	正向电压		3.6		V	I _{SD} =30A, V _{GS} =0V	图 10, 11, 12
			3.4		V	I _{SD} =30A, V _{GS} =0V, T _J =175°C	
t _{rr}	反向恢复时间		54		ns	V _{GS} =-3.5V/+18V, I _{SD} =60A, V _R =800V, R _{G(ext)} =10Ω L=200μH	
Q _{rr}	反向恢复电荷		383.8		nC	di/dt=3000A/μs	
I _{RRM}	反向恢复峰值电流		25.3		A		

典型特征曲线

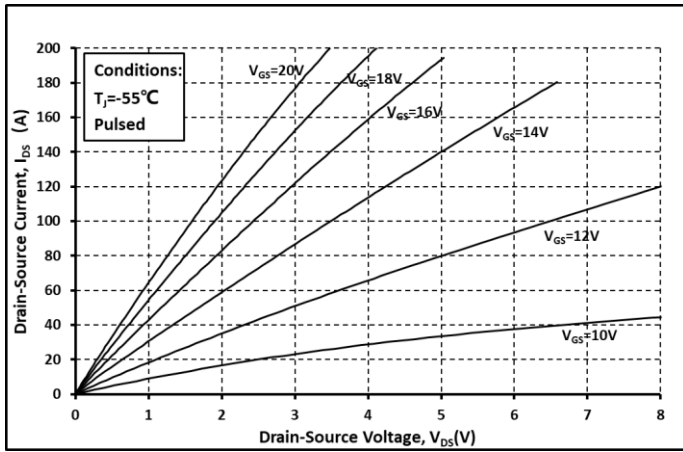


图. 1 输出曲线 @ $T_j = -55^\circ\text{C}$

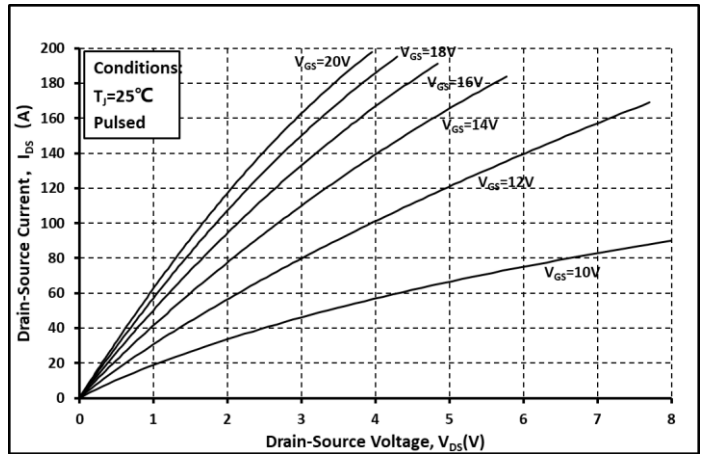


图. 2 输出曲线 @ $T_j = 25^\circ\text{C}$

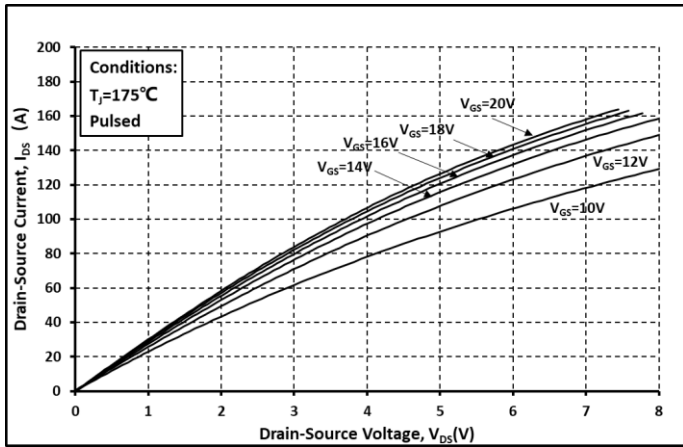


图. 3 输出曲线 @ $T_j = 175^\circ\text{C}$

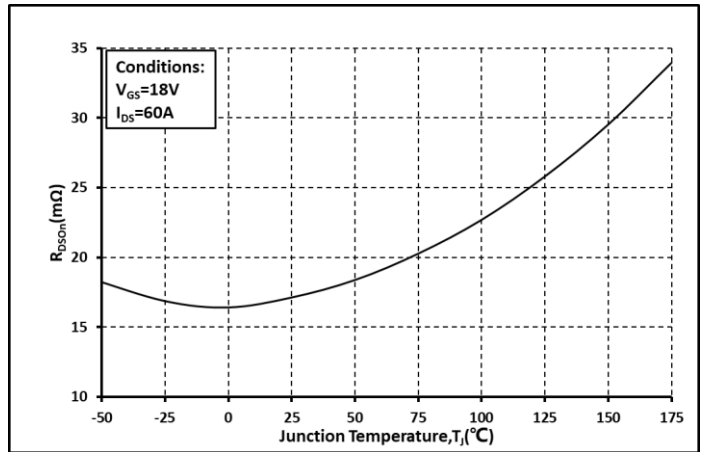


图. 4 R_{on} 和温度关系曲线

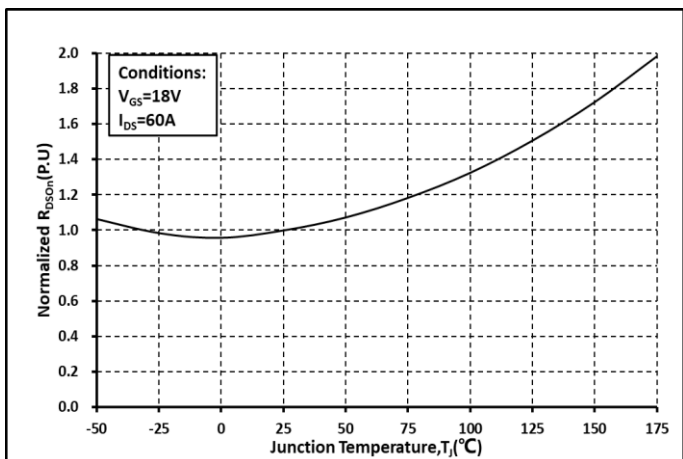


图. 5 归一化的 R_{on} 和温度关系曲线

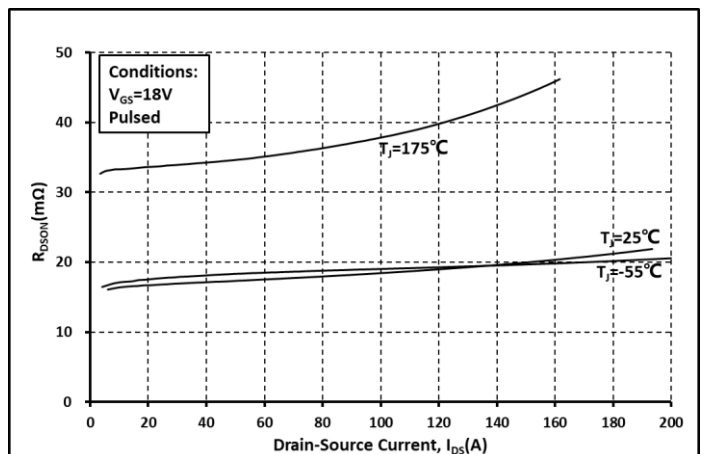


图. 6 各温度下的 R_{on} 和 I_{DS} 关系曲线

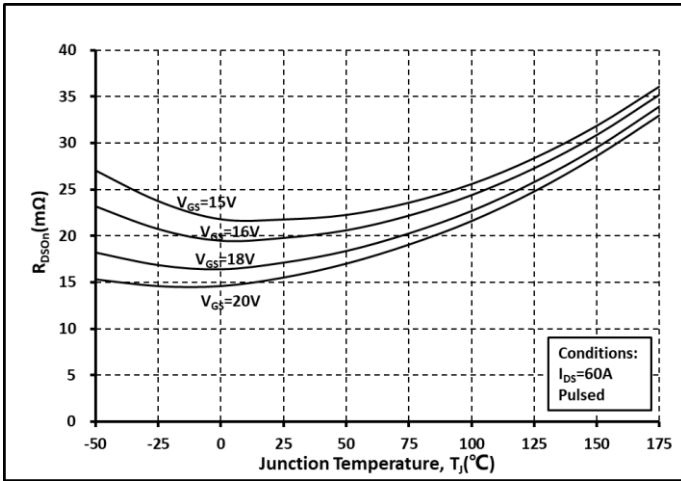


图. 7 各 V_{GS} 下的 R_{on} 和温度关系曲线

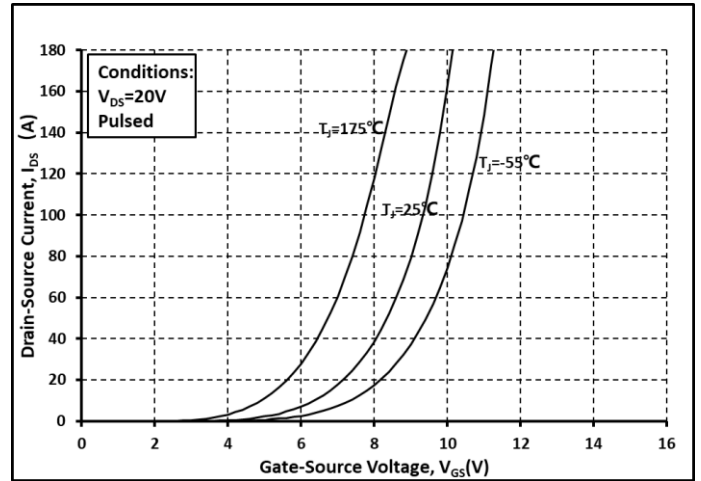


图. 8 各温度下的传输特性曲线

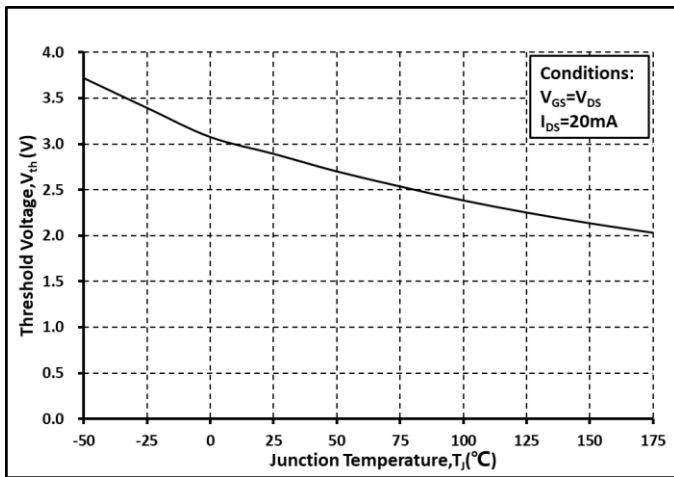


图. 9 阈值电压随温度变化曲线

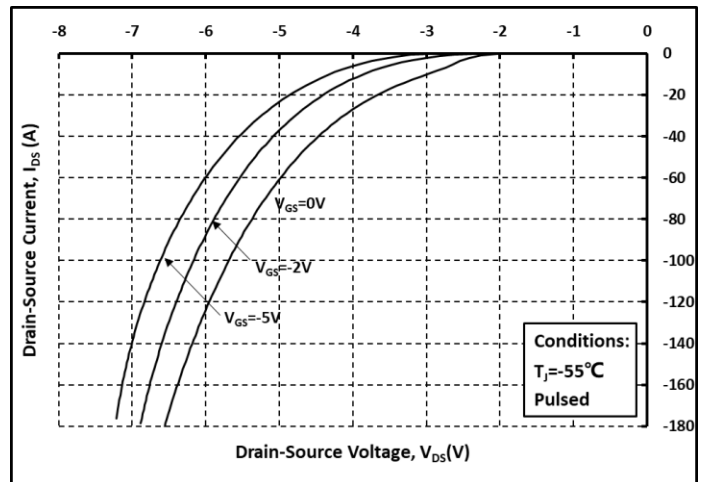


图. 10 体二极管导通曲线 @ $T_j = -55^\circ C$

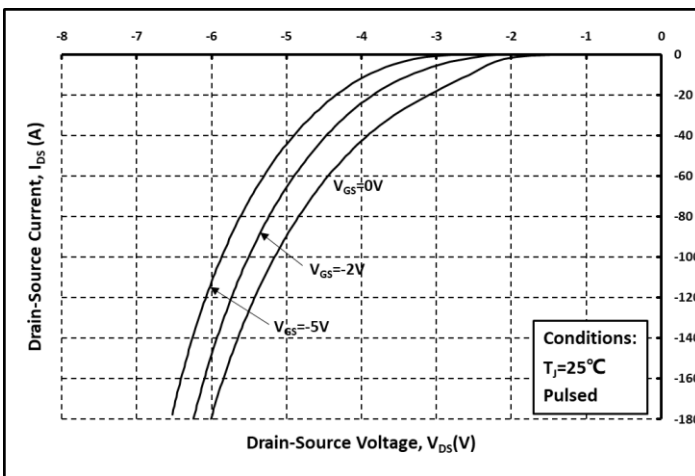


图. 11 体二极管导通曲线 @ $T_j = 25^\circ C$

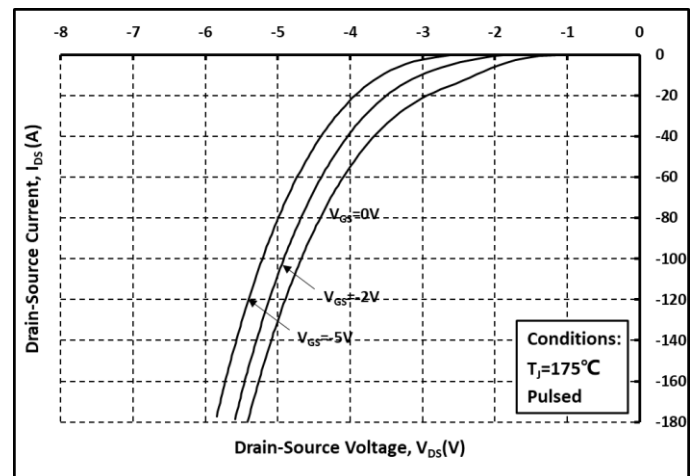


图. 12 体二极管导通曲线 @ $T_j = 175^\circ C$

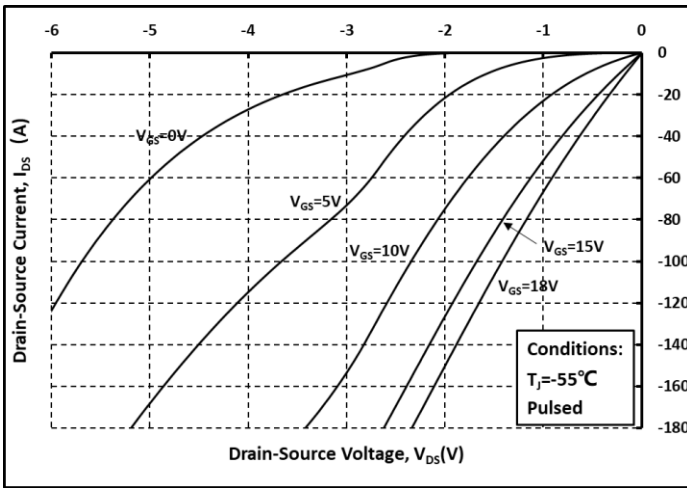


图. 13 第三象限曲线 @ $T_j = -55^\circ\text{C}$

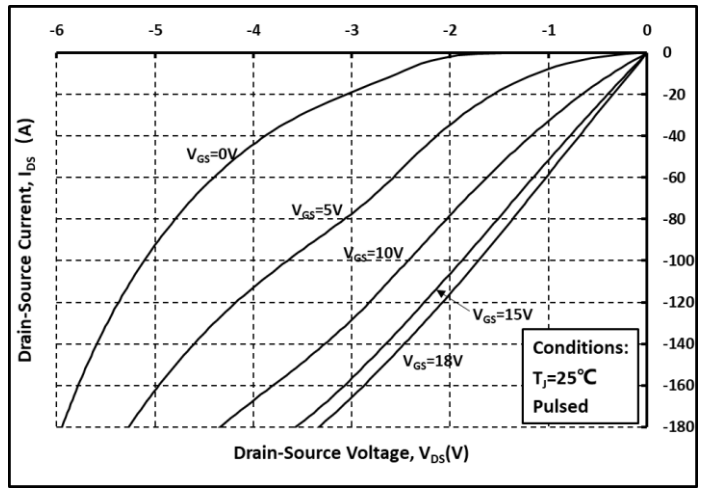


图. 14 第三象限曲线 @ $T_j = 25^\circ\text{C}$

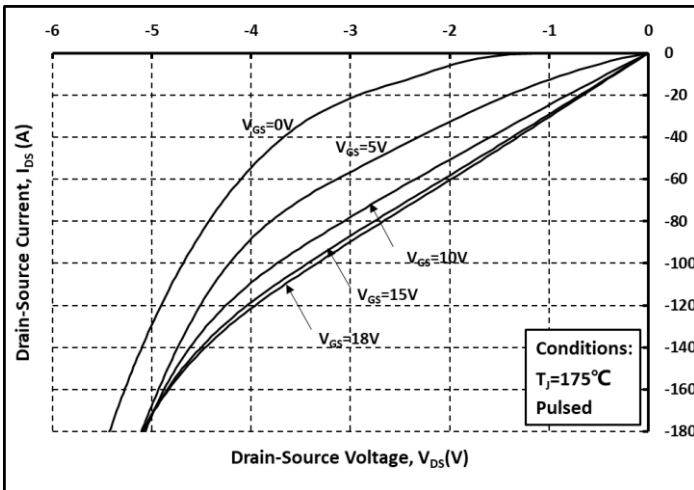


图. 15 第三象限曲线 @ $T_j = 175^\circ\text{C}$

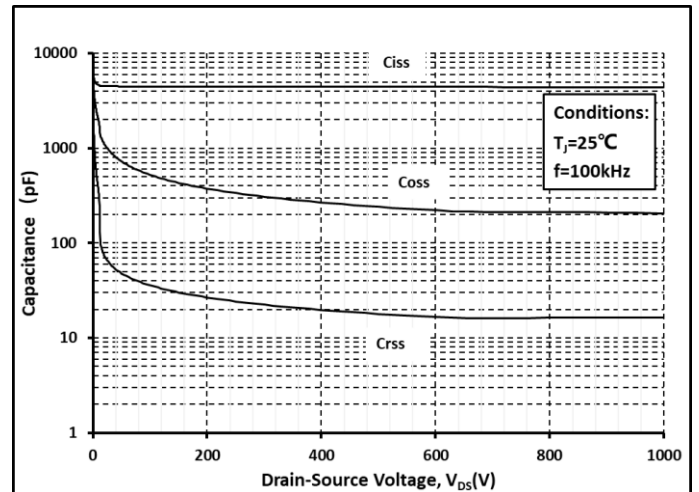


图. 16 各电容和 V_{DS} 关系曲线

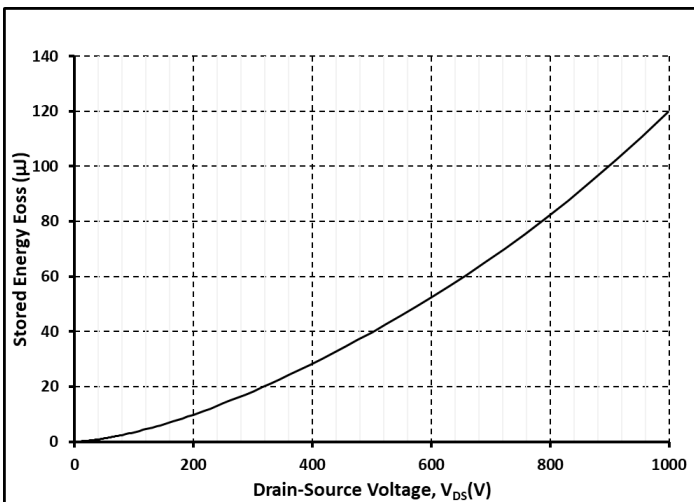


图. 17 输出电容存储能量曲线

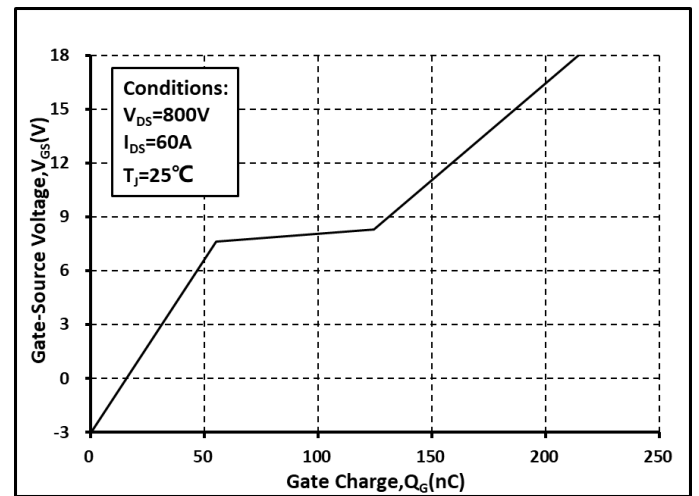


图. 18 栅电荷特征曲线

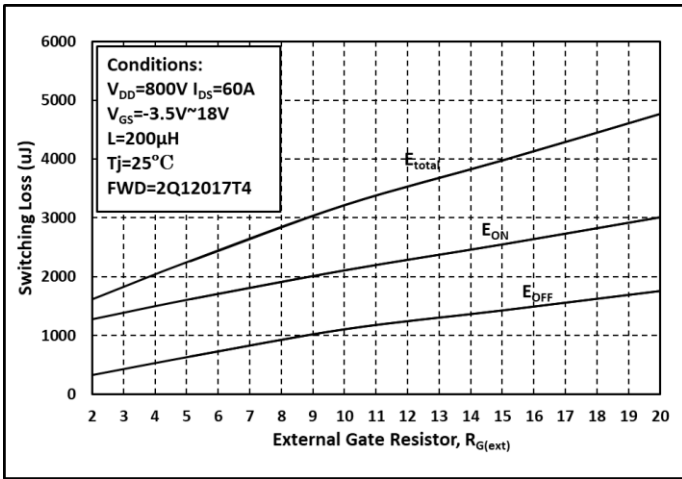


图. 19 开关能量和栅极电阻 $R_{G(ext)}$ 关系曲线

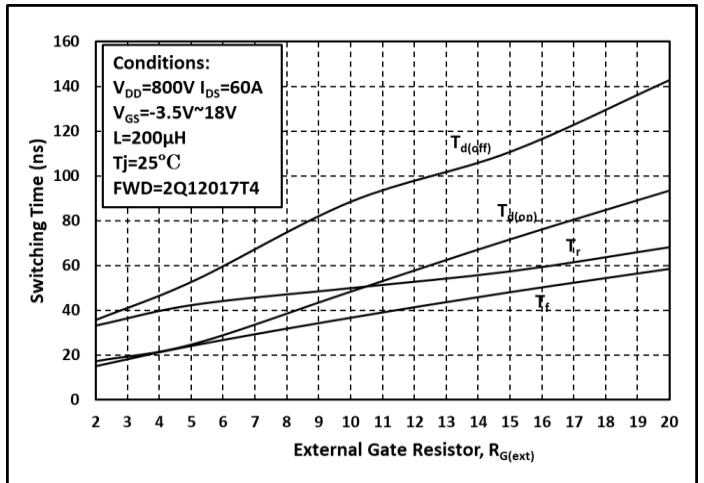


图. 20 开关时间和栅极电阻 $R_{G(ext)}$ 关系曲线

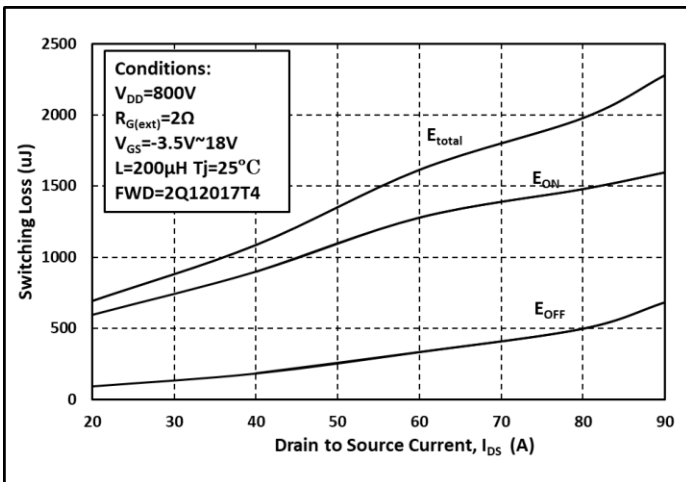


图. 21 开关能量和漏端电流 I_{DS} 关系曲线

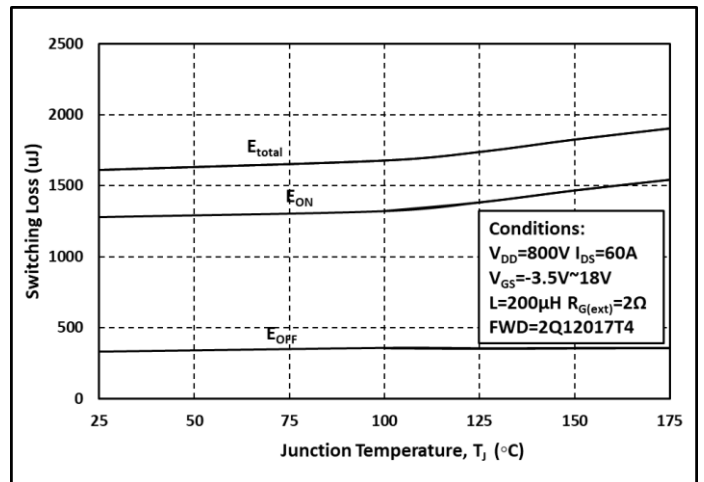


图. 22 开关能量和温度关系曲线

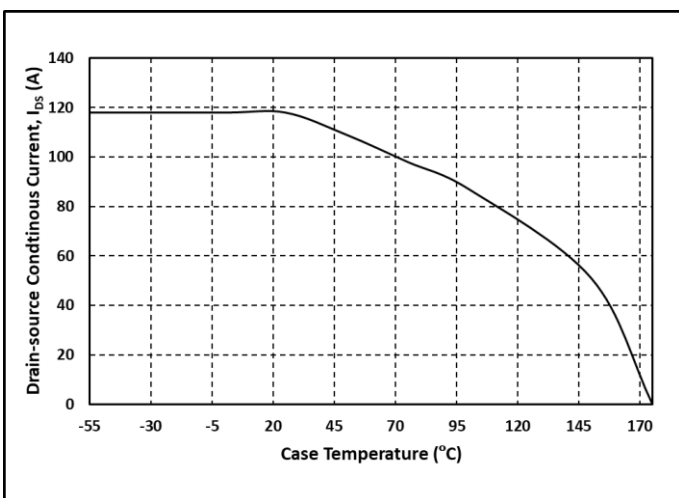


图. 23 漏端电流和温度关系曲线

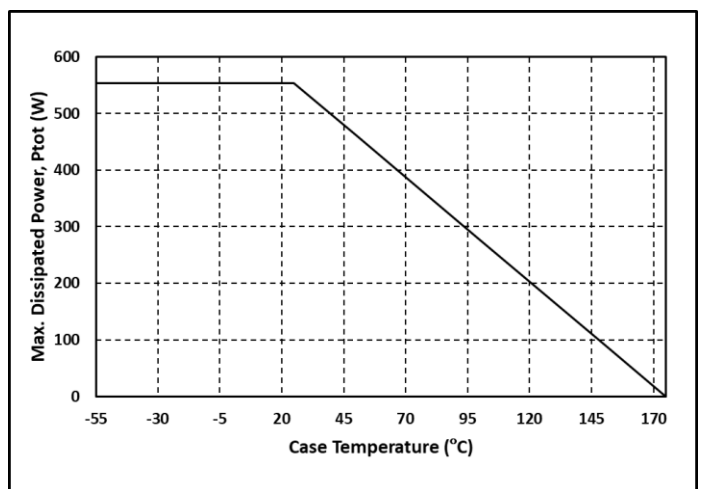


图. 24 最大功耗降额和温度关系曲线

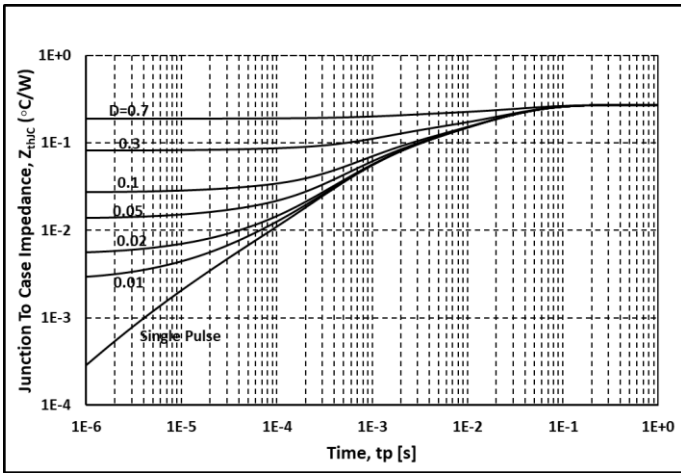


图. 25 热阻曲线

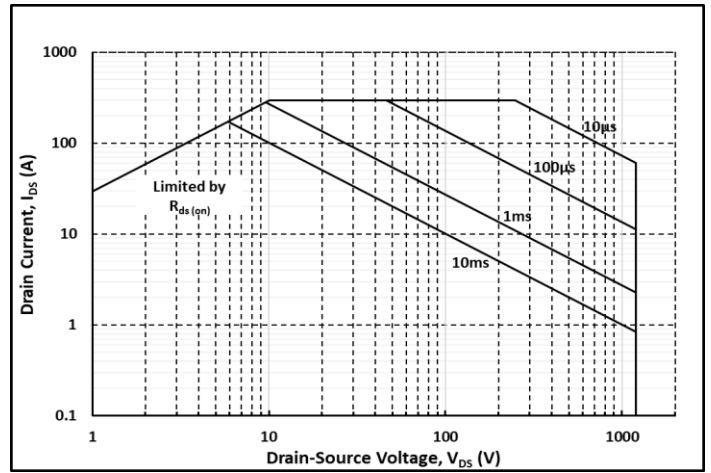
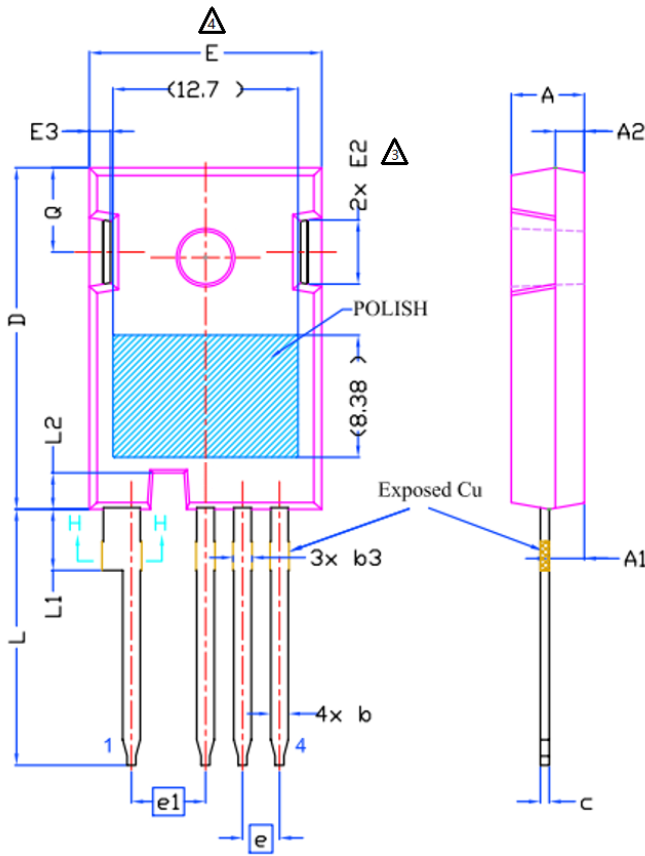
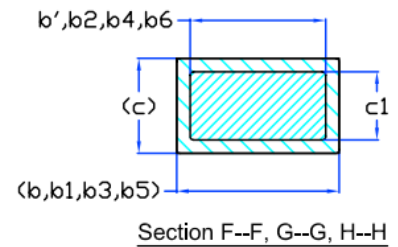
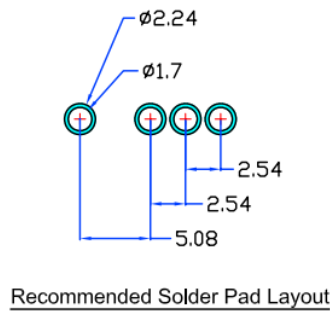
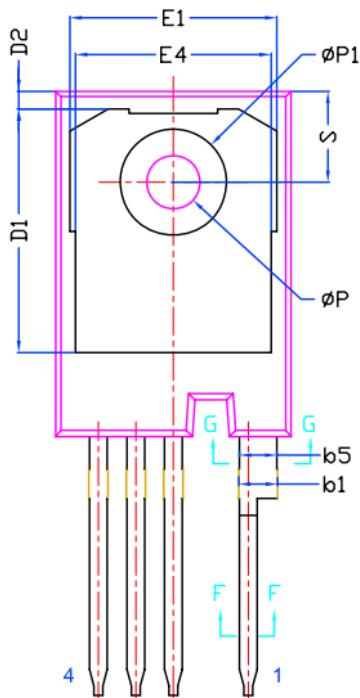


图. 26 安全工作区示意图

封装尺寸



Dimensions In Millimeters		
SYMBOL	MIN.	MAX.
A	4.83	5.21
A1	2.29	2.54
A2	1.91	2.16
b	1.07	1.33
b'	1.07	1.28
b1	2.39	2.94
b2	2.39	2.84
b3	1.07	1.60
b4	1.07	1.50
b5	2.39	2.69
b6	2.39	2.64
c	0.55	0.68
c1	0.55	0.65
D	23.30	23.60
D1	16.25	17.65
D2	0.95	1.25
E	15.75	16.13
E1	13.10	14.15
E2	3.68	5.10
E3	1.00	1.90
E4	12.38	13.43
e	2.54 BSC	
e1	5.08 BSC	
L	17.31	17.82
L1	3.97	4.37
L2	2.35	2.65
N	4	
φP	3.51	3.65
φP1	7.18 REF.	
Q	5.49	6
S	6.04	6.3



说明:

1. 封装标准参考: JEDEC TO247, Variation AD
2. 以上单位为: 毫米
3. 需要开槽, 槽口可为圆形
4. 尺寸 D 和 E 不包括模具溢料
5. 如有变更, 不另行通知

注意

欲了解更多的产品及公司信息，敬请联系 IVCT 公司办公人员或登录公司网站。

Copyright©2023 InventChip Technology Co., Ltd. All rights reserved.

本文档中的信息如有变更，恕不另行通知。

相关链接

<http://www.inventchip.com.cn>



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>Inventchip\(瞻芯电子\)](#)